PAT-NO: JP353100259A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 53100259 A

THILE: COUPLING SYSTEM OF LIGHT EMITTING ELEMENT AND OPTICAL
FIELER

PUBN-DATIE: September 1, 1978

INVENITORANFORMATION: NAME ISHII, YASUHIRO SAKUTA, MASAAKI USUI, KIYOSHI ICHIKAWA, SHIRO

ASSIGNEE INFORMATION:
NAME
OKITELECTRIC IND COLLID
NA

APPL-NO: JP52014181

APPL-DATE: February 14, 1977

INT-CL (IPC): G02B005/14, H01B011/00, H01P003/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the coupling efficiency of a light emitting element and an optical fiber by letting the light radiated from a light emitting element enter from the cylindrical peripheral wall face of an optical fiber by way of a light scattering medium mixed with the granules.

COPYRIGHT: (C)1978, JPO&Japio

10/11/05, EAST Version: 2.0.1.4

19日本国特許庁

10特許出願公開

公開特許公報

60日本分類

104 A 0

广内整理番号

7244-23

昭53—100259

49公開 昭和53年(1978)9月1日

H 01 B H 01 P	3/00 3/00	104 G 0		7244—23 7448—23 6545—53 2109—53	3 3	発明の数 1 審査請求 未請求 (全 6 頁)
分発光素②特	子・対願	光フアイバ結合方式 グ 昭52—14181		@ 発	明者	薄井潔 東京都港区芝琴平町10番地 沖 電気工業株式会社内
念 出	願	昭52(1977) 2 月14日		同		市川志郎
⑦発 明	者	石井康博 東京都港区芝琴平町10番地	沖			東京都港区芝琴平町10番地 沖電気工業株式会社内
同		電気工業株式会社内 佐久田昌明		⊕出 □	願人	沖電気工業株式会社 東京都港区芝琴平町10番地
		東京都港区芝琴平町10番地 電気工業株式会社内	沖	9 代:	理人	弁理士 菊池弘

明細書

識別記号

1 発明の名称

Mint. Cl.2

G 02 B 5/14

発光素子・光ファイパ結合方式。

2. 特許請求の範囲

8. 発明の詳細な説明

との発明は光ファイペ伝送装置のための高効率 高光出力の送信機を実現する上での発光素子・光 ファイペ結合方式に関するものである。

第1図は従来の発光業子と光ファイペとの結合

方式の原理を説明するための構造図であり、との図において、発光素子は n 形半導体基板結晶 1 と 円板状の P 層 2 とによる p ー n 接合 3 で構成され、 コ ア 4 および クラッド 5 からなる光ファイベの機 断面 6 を p ー n 接合 3 に近接せしめて両者間での 光結合を行なつている。

との発明は上記の点に鑑みなされたもので、発 光素子から放射された光を、粒体を混入した光散

特開 昭53-100259(2)

乱媒体を介して光ファイベの円筒状関盤面から流入させることにより、発光素子と光ファイベとの結合効率の理論限界を飛躍的に改善するとともに、コア断面積よりも大きな発光面を有する発光素子の適用を可能にして光ファイベ出力を飛躍的に向上させ得る発光素子・光ファイベ結合方式を提供することを目的とする。

以下との発明の実施例について説明する。

第2図はこの発明の基本原理を説明するための基本的構造の一実施例を示す図で、この図において、発光素子は『形半導体基板結晶111にリング状の『層12を設けてなるリング状』「「接合13で構成され、リング内の基板結晶では、光学的になるように金属薄膜14が設けられている。一方、コア15とクラッド16とよりなるアアイスは、先端合コア部17が設けられており、この場合支持体18にはコア経と嵌合する部分19と、隙間部分20が設けられており、この支持体

18の隙間部分20と結合コア部17との空間には、充てん材としての有機材料中にたとえば MgO 結晶のような無機質の微粒体を混入した媒体を注入した媒体21が設けられる。つまり、光散乱媒体21は結合コア部17の円筒状局壁面を行うように設けられるもので、さらに光散乱媒体21の外周面は、支持体18からなる反射率のよいたとは金属体で優われることになる。そして、光散乱媒体21のリング状始面22にリング状トーロ接合面を近接して、上記光ファイバ例と発光案子とが配置される。

次に、動作について説明するが、光散乱媒体21 を構成する充てん材としての有機材料(有機溶剤 および樹脂)ならびに混入される無機質粒体には、 共に光伝送に使用する波長帯域で光の透過率が良 好な物質を選定するものであり、このような物質 の充てん材および粒体からなる光散乱媒体21に 光が入射されると、粒体の光学的性質により散乱 が起る。この粒体による散乱現象には、複数粒体 における Rayleigh 散乱と粒体界面の反射屈折に

ある。この発明の原理は何れの散乱に対しても成立するが、工業的な見地から極度の粒子の微細化を必要としない粒体界面での反射屈折による散乱の場合について説明すると、多数の粒体を混入した光散乱媒体21中では、多重散乱現象が起り、その程度は粒体と充てん材との屈折率差が大きい程、粒体密度が高く界面総面積が大きい粒体を固大きい。またこの場合、粒体形状は任意でよく、粒体結晶および粉砕方法により定まるいかなる固有の形状でもよいもので、このような粒体を混入した光散

乱媒体 2 1 に光が入射されると、この光散乱媒体

21の形状、入射光の入射角に無関係に、入射光

は光散乱媒体21内をほぼ均一に分散する。

よるMie 散乱との2つがあることは周知の通りで

.

したがつて、発光素子のリング状 P-n接合13から放射された光は、円環柱状の光散乱媒体 21に対してそのリング状婚面 22から入射された後、光散乱媒体 21中に均一に分散される。ここで、光ファイパの結合コア部 17と光散乱媒体 21との界面を考えると、コア材と充てん材とが接触し

(a) 粒体の屈折率>充てん材の屈折率>コア 1 5 の屈折率

(b) 粒体の屈折率>コア15の屈折率>充てん材 の屈折率

となり、(a) の場合にはコア材と接触している粒体 および充てん材の全界面での屈折が、(b) の場合に はコア材と接触している粒体の界面での屈折が光

特開 昭53-100259(4)

らの発光出力が光散乱媒体 62を介して有限是の 集光コア63に導かれ、との集光コア63に光フ アイパ64を結合せしめるように構成されるもの で、上配光散乱媒体62は集光コア63の円筒状間 壁面および横断面を覆うように設けられ、外周面 には金属皮膜 6.5 が被覆される。そして、この実 施例においては、集光コア 63の小片を半導体素 子に一体的に固定し、光ファイペ64個も特に結 合コア部を設けない通常の光ファイパそのものを 使用可能であり工業的な組立作業に好都合である という付加的な効果がある。なお、この実施例の 場合、光ファイベ64のコア径より細い径の集光 コア63に設計することにより、両者間に必要な 軸合わせ精度を軽減できる。

以上多くの実施例で詳述したように、この発明 は低めて広範囲の構成形態に対しても効果的に進 用可能である優れた特徴を有するが、最後にこの 発明の工業的な実施形態を記述する。まず、との 発明の基礎をなす光散乱媒体に関して、混入され る粒体としては、光伝送で使用される波畏坡が通 常 0.7~ 1.5 µm であることを考え、この放長域 て透過率のよい物質として、ガラス砕份、酸化ア ルミニウム (A42Os)、 炭化カルシウム (CaCz)、 酸化マグネシウム (MgO)、ダイヤモンド()、リン 化ガリウム (GaP) などの無色あるいは白色粒体 がすべて有効に使用可能であり、これらの物質の **微細粒体化も顔料、 黧菜、 研磨材などの工業にお** いて汎用技術として広く使用されている。一方。 充てん材としては、ピニールアセテート系、メチ ルメタクリレート来,シアノクリレード来,シリ コン系などの透明樹脂材が好適である。なお、と の発明における充てん材は、実施例で詳述した光 伝送媒体としての機能に加えて、発光案子と光フ アイパとの位置固定のための接着剤としての機能 も果している。また、発光素子としては、GaAs, GaAsP、GaALAs などを基材とする拡散法によ るp-n接合、エピタキシャル成長法によるpn 接合、ヘテロ接合、ダブルヘテロ接合などのい ナれの接合に対してもこの発明をできることは勿! 2字加入

状方向についても、通常の円板状発光面は勿論の こと、メサエッチ成形されたエッチギッション形 の発光案子に対しても効果的に適用可能である。

以上詳述したように、この発明によれば、発光 紫子と光ファイバとの結合効率の理論限界を飛躍 的に改善するとともに、コア断面よりも大きな発 光面を有する発光素子の適用を可能にして光ファ イベ出力を飛躍的に向上させ得る発光素子・光フ アイパ結合方式を提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の発光素子・光ファイバ結合方式 を示す断面図、第2図はこの発明による発光素子・ 光ファイバ結合方式の一実施例を示す断面図、第 3 図ないし第7 図はそれぞれとの発明の他の実施 例を示す断面図である。

13…p-n接合、15…コア、16…クラツ ド、17…結合コア部、18…支持体、21…先散 乱媒体、 3 1 … p - n 接合、 3 2 …結合コア部、 33...光散乱媒体、34...円筒状隔壁面、35...模 断面、41…結合コア部、42…光飲乱媒体、43

··· 金属皮膜、 4 4 ··· p - n 接合、 4 5 ··· 結合コア 部、 4 6 … 光散乱媒体、 4 7 … 金属皮膜、 4 8 … p-n接合、51…p-n接合、52…金属皮膜、 5 3 … 光ファイペ、 5 4 … 結合コア部、 5 5 … 光 散乱媒体、 5 6 ··· 金属皮膜、 6 1 ··· p - n 接合、 62…光散乱媒体、63…集光コア、64…光フ アイパ、65…金属皮膜。

冲電気工業株式会社 特斯出國人

44 弁理士 玴

弘









